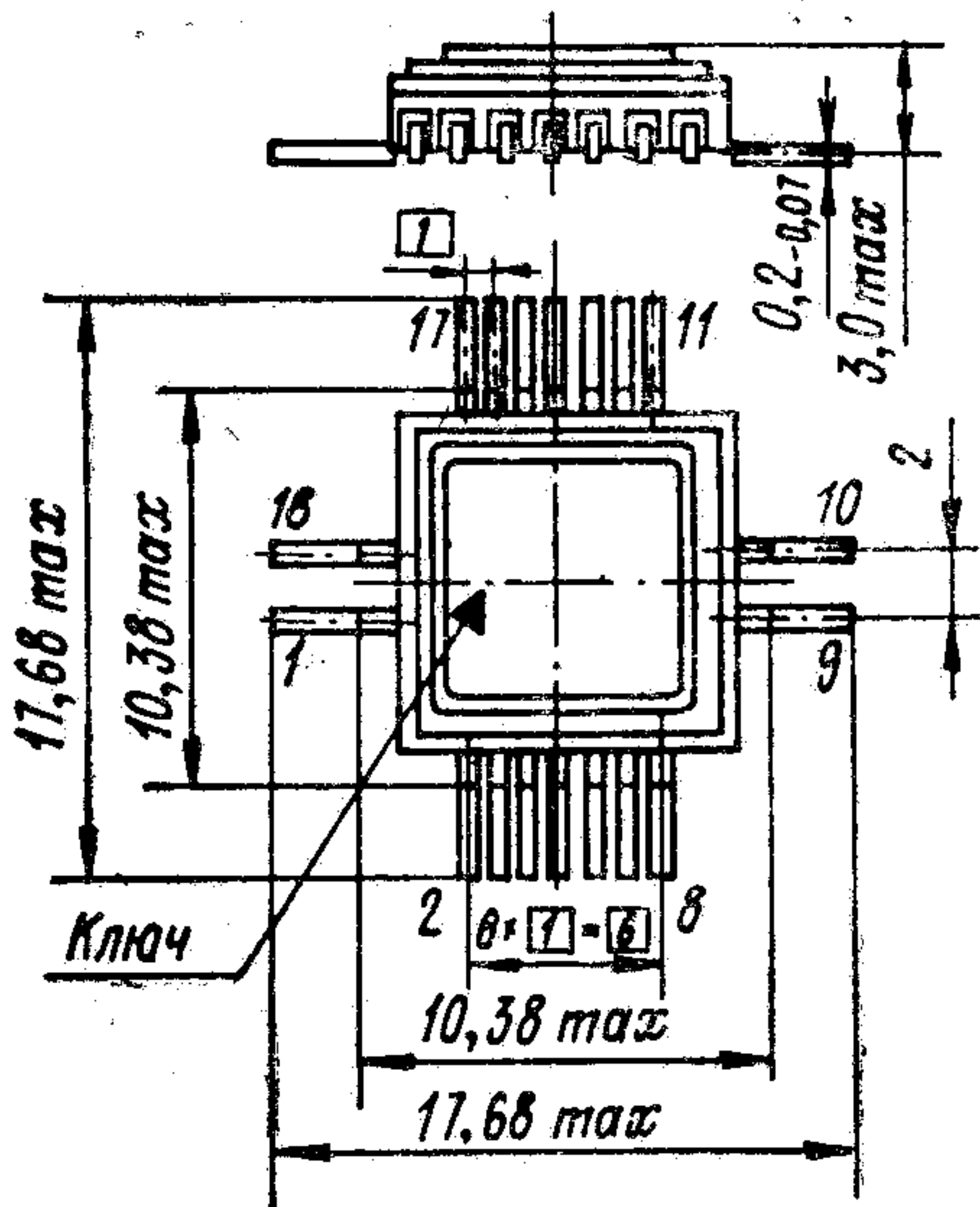


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ Н320

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 0,9 г

Форма ключа не регламентируется.

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	1—5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	15 000 (1500)
длительность действия ударного ускорения, мс	0,1—2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	1—5

Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)

5000 (500)

Атмосферное пониженное давление, (мм рт. ст.) Па

(10^{-6}) $1,3 \cdot 10^{-4}$

Атмосферное повышенное давление, атм

3

Повышенная температура среды, $^{\circ}\text{C}$

125

Пониженная температура среды, $^{\circ}\text{C}$

минус 60

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ Н320

Общие данные

Изменение температуры среды, °С	от минус 60 до +125
Повышенная относительная влажность при температуре 35°С, %	98
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка микросхем при $P_{\text{рас}} = 0,3$ Вт и $t = 85^{\circ}\text{C}$, ч	25 000
Срок сохраняемости ^О , лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Перед установкой микросхем на керамические платы производится обрубка и формовка выводов в соответствии с габаритным чертежом, затем осуществляется лужение выводов.

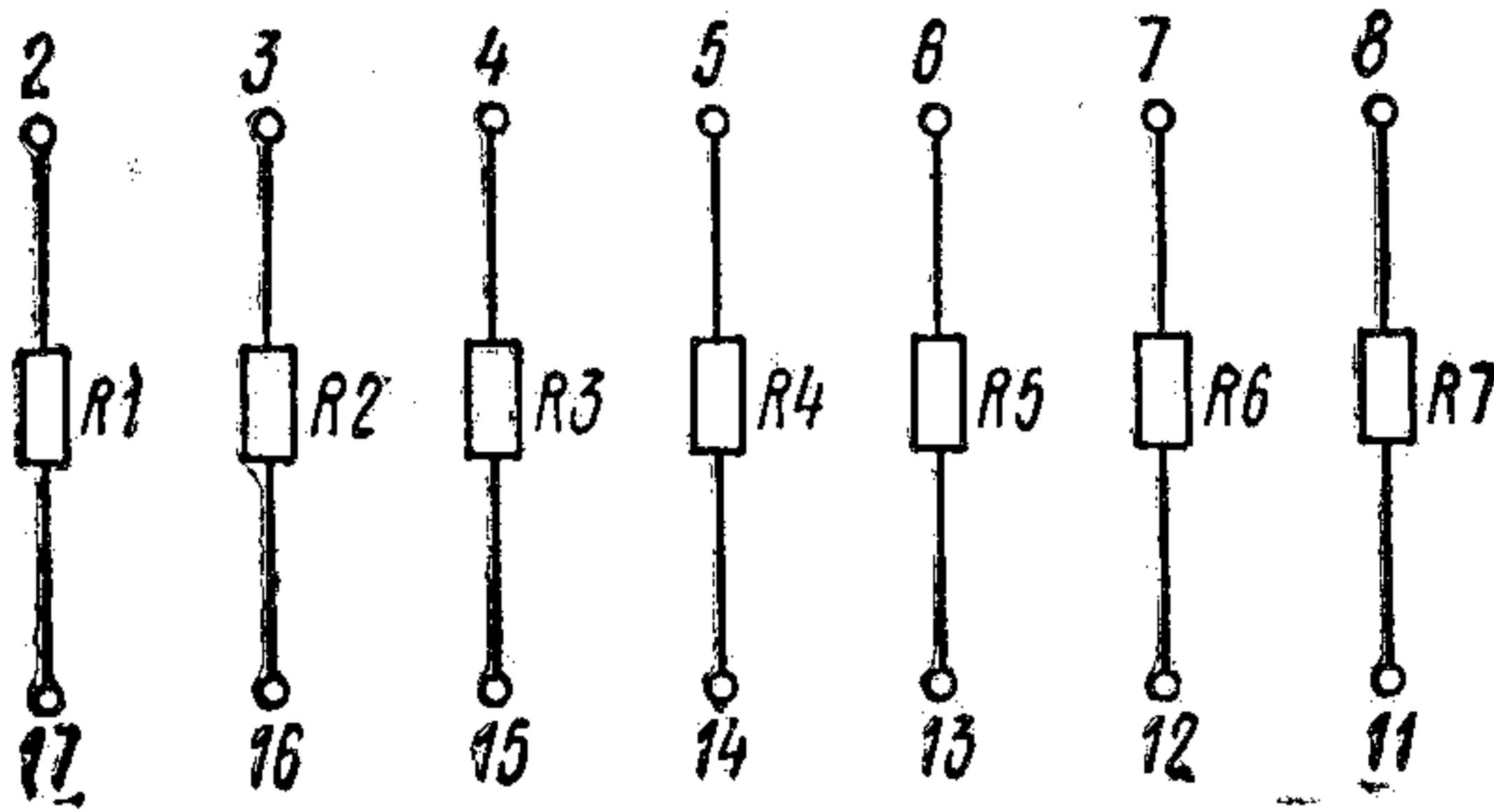
Перед пайкой микросхемы устанавливаются на керамические платы, предварительно нагретые до температуры 120°С, после чего потоками нагретых газов осуществляется нагрев микросхемы и локальный нагрев (места пайки на керамической плате до расплавления) припоя. При этом микросхему нагревают сверху (температура газа равна $220 \pm 10^{\circ}\text{C}$), а керамическую плату нагревают снизу (температура газа равна $380 \pm 20^{\circ}\text{C}$). Общий нагрев керамической платы с микросхемами не должен превышать 250°С. Длительность нахождения одной микросхемы при температуре расплавления припоя при пайке — не более 1 мин.

Допускается повторное (но не более 3 раз) использование демонтированных микросхем при общей продолжительности нагрева микросхемы не более 1 мин. Допускается кратковременный нагрев резисторов при сборке до температуры 250°С в течение не более 1 мин.

Допустимое значение статического потенциала 200 В.

^О В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



$R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = R7.$

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Сопротивление изоляции между выводами, Ом, не менее $50 \cdot 10^6$
 Паразитная емкость между резисторами, пФ, не более 5
 Сопротивление резисторов

Номинальное значение сопротивления резистора, Ом	Предельно допустимые значения сопротивления, Ом	Номинальное значение сопротивления резистора, Ом	Предельно допустимые значения сопротивления, Ом
100	От 97 до 103	300	От 291,0 до 309,0
110	» 106,7 » 113,3	330	» 320,1 » 339,9
120	» 116,4 » 123,6	360	» 349,2 » 370,8
130	» 126,1 » 133,9	390	» 378,3 » 401,7
150	» 145,5 » 154,5	430	» 417,1 » 442,9
160	» 155,2 » 164,8	470	» 455,9 » 484,1
180	» 174,6 » 185,4	510	» 494,7 » 525,3
200	» 194,0 » 206,0	560	» 543,2 » 576,8
220	» 213,8 » 226,6	620	» 601,4 » 638,6
240	» 232,8 » 247,2	680	» 659,6 » 700,4
270	» 261,9 » 278,1	750	» 727,5 » 772,5

Продолжение

Номинальное значение сопротивления резистора, Ом	Предельно допустимые значения сопротивления, Ом	Номинальное значение сопротивления резистора, Ом	Предельно допустимые значения сопротивления, Ом
820	От 795,4 до 844,6	$5,1 \cdot 10^3$	От $4,947 \cdot 10^3$ до $5,253 \cdot 10^3$
910	» 882,7 » 937,3	$5,6 \cdot 10^3$	» $5,432 \cdot 10^3$ » $5,768 \cdot 10^3$
$1,0 \cdot 10^3$	» $0,970 \cdot 10^3$ » $1,030 \cdot 10^3$	$6,2 \cdot 10^3$	» $6,014 \cdot 10^3$ » $6,386 \cdot 10^3$
$1,1 \cdot 10^3$	» $1,067 \cdot 10^3$ » $1,133 \cdot 10^3$	$6,8 \cdot 10^3$	» $6,596 \cdot 10^3$ » $7,004 \cdot 10^3$
$1,2 \cdot 10^3$	» $1,164 \cdot 10^3$ » $1,236 \cdot 10^3$	$7,5 \cdot 10^3$	» $7,275 \cdot 10^3$ » $7,275 \cdot 10^3$
$1,3 \cdot 10^3$	» $1,261 \cdot 10^3$ » $1,339 \cdot 10^3$	$8,2 \cdot 10^3$	» $7,954 \cdot 10^3$ » $8,446 \cdot 10^3$
$1,5 \cdot 10^3$	» $1,455 \cdot 10^3$ » $1,545 \cdot 10^3$	$9,1 \cdot 10^3$	» $8,827 \cdot 10^3$ » $9,373 \cdot 10^3$
$1,6 \cdot 10^3$	» $1,552 \cdot 10^3$ » $1,648 \cdot 10^3$	$10 \cdot 10^3$	» $9,700 \cdot 10^3$ » $10,300 \cdot 10^3$
$1,8 \cdot 10^3$	» $1,746 \cdot 10^3$ » $1,854 \cdot 10^3$	$11 \cdot 10^3$	» $10,670 \cdot 10^3$ » $11,330 \cdot 10^3$
$2,0 \cdot 10^3$	» $1,940 \cdot 10^3$ » $2,060 \cdot 10^3$	$12 \cdot 10^3$	» $11,640 \cdot 10^3$ » $12,360 \cdot 10^3$
$2,2 \cdot 10^3$	» $2,134 \cdot 10^3$ » $2,266 \cdot 10^3$	$13 \cdot 10^3$	» $12,610 \cdot 10^3$ » $13,340 \cdot 10^3$
$2,4 \cdot 10^3$	» $2,328 \cdot 10^3$ » $2,472 \cdot 10^3$	$15 \cdot 10^3$	» $14,550 \cdot 10^3$ » $15,450 \cdot 10^3$
$2,7 \cdot 10^3$	» $2,619 \cdot 10^3$ » $2,781 \cdot 10^3$	$16 \cdot 10^3$	» $15,520 \cdot 10^3$ » $16,480 \cdot 10^3$
$3,0 \cdot 10^3$	» $2,910 \cdot 10^3$ » $3,090 \cdot 10^3$	$18 \cdot 10^3$	» $17,460 \cdot 10^3$ » $18,540 \cdot 10^3$
$3,3 \cdot 10^3$	» $3,201 \cdot 10^3$ » $3,399 \cdot 10^3$	$20 \cdot 10^3$	» $19,400 \cdot 10^3$ » $20,600 \cdot 10^3$
$3,6 \cdot 10^3$	» $3,492 \cdot 10^3$ » $3,708 \cdot 10^3$	$22 \cdot 10^3$	» $21,340 \cdot 10^3$ » $22,660 \cdot 10^3$
$3,9 \cdot 10^3$	» $3,783 \cdot 10^3$ » $4,017 \cdot 10^3$	$24 \cdot 10^3$	» $23,280 \cdot 10^3$ » $24,720 \cdot 10^3$
$4,3 \cdot 10^3$	» $4,171 \cdot 10^3$ » $4,429 \cdot 10^3$	$27 \cdot 10^3$	» $26,190 \cdot 10^3$ » $27,810 \cdot 10^3$
$4,7 \cdot 10^3$	» $4,559 \cdot 10^3$ » $4,841 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$	» $29,100 \cdot 10^3$ » $30,900 \cdot 10^3$

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальная мощность рассеяния, Вт:	
одного резистора	0,075
микросхемы	0,3
Максимальное входное напряжение, В	20
Максимальная температура нагрева микросхемы, °С	200